

ピン付き埋込みフォトダイオードの発明と歴史的開発努力【JST・京大機械翻訳】

著者 (1件) : [Hagiwara Yoshiaki](#) ([Artificial Intelligent Partner System \(AIPS\)](#), [AIPLAB](#), [Atsugi-city, Japan](#)).

資料名 : [IEEE Conference Proceedings](#) ([IEEE Conference Proceedings](#)).

巻 : 2021 号 : ICECET ページ : 1-6 発行年 : 2021年

JST資料番号 : W2441A 資料種別 : 会議録 (C)

記事区分 : 原著論文 発行国 : アメリカ合衆国 (USA) 言語 : 英語 (EN)

抄録/ポイント : 本論文は,電気シャッタ機能能力を実現するために,画素内垂直オーバーフローレイン(VOD)関数を有するP+NP Nサブ三重接合型動的光サイリスタ構造の形式で最初に定義された,Hole蓄積装置(HAD)と呼ばれる,SonyにおけるYoshaki Hagiwaraによる1975年のPinned Buried Photoダイオードの発明をレビューした。この発明の証拠は1975年にサニーでHagiwaraによって適用された3つの日本の特許応用によって説明される。最初の二重接合型Pinnedフォトダイオードも1978年にSonyでHagiwaraチームにより開発し,東京の日本の国内SSDM1978会議で報告した。1975年にHagiwaraによってファイルされた3つのオリジナルな日本の特許応用は,発明のエビデンスであったが,しかし,USPおよび他の海外特許で適用されていない日本人および不幸にも書かれた。この詳細を現在レビューし,ここでは,IEEE英語発話コミュニティにおける最初の日本語特許アプリケーションの英語翻訳について初めて開示した。三重接合型Pined Briedフォトダイオードは,本質的に画像-遅れの無い特徴,ピクセル内VOD機能および電気シャッタ機能能力を持ち,それは,現代の高精細固体デジタルカメラから,完全に膜メディアおよび機械部品を置換した。Copyright 2022 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST. 【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語 : [接合](#) , [*ダイオード](#) , [*フォトダイオード](#) , [機械要素](#) , [日本語](#) , [コミュニティ](#) , [IEEE](#) , [英語](#) , [画素](#) , [応用プログラム](#) , [シャッタ](#) , [発話](#) , [ディジタルカメラ](#) , [日本人](#)

分類 (1件) : 図形・画像処理一般 ([JE04010I](#))

[How to make Multi Junction Solar Cell Yoshiaki Hagiwara.html](#)